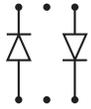


CMKD3003DO

**SURFACE MOUNT
DUAL, ISOLATED, OPPOSING
LOW LEAKAGE SILICON
SWITCHING DIODES**

ULTRAmTMini



SOT-363 CASE

Central
Semiconductor Corp.

www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMKD3003DO contains two (2) Isolated Opposing Silicon Switching Diodes, manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a ULTRAmTMini surface mount package. These devices are designed for switching applications requiring extremely low leakage.

MARKING CODE: C303

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)

Continuous Reverse Voltage
Average Rectified Current
Continuous Forward Current
Peak Repetitive Forward Current
Peak Forward Surge Current, t_p=1.0μs
Peak Forward Surge Current, t_p=1.0s
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

V_R 180
I_O 200
I_F 600
I_{FRM} 700
I_{FSM} 2.0
I_{FSM} 1.0
P_D 350
T_J, T_{stg} -65 to +150
θ_{JA} 357

UNITS

V
mA
mA
mA
A
A
mW
°C
°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: (T_A=25°C unless otherwise noted)

| SYMBOL | TEST CONDITIONS | MIN | MAX | UNITS |
|-----------------|---|------|------|-------|
| I _R | V _R =125V | | 1.0 | nA |
| I _R | V _R =125V, T _A =150°C | | 3.0 | μA |
| I _R | V _R =180V | | 10 | nA |
| I _R | V _R =180V, T _A =150°C | | 5.0 | μA |
| BV _R | I _R =5.0μA | 200 | | V |
| V _F | I _F =1.0mA | 0.62 | 0.72 | V |
| V _F | I _F =10mA | 0.72 | 0.83 | V |
| V _F | I _F =50mA | 0.80 | 0.89 | V |
| V _F | I _F =100mA | 0.83 | 0.93 | V |
| V _F | I _F =200mA | 0.87 | 1.10 | V |
| V _F | I _F =300mA | 0.90 | 1.15 | V |
| C _T | V _R =0, f=1.0MHz | | 4.0 | pF |

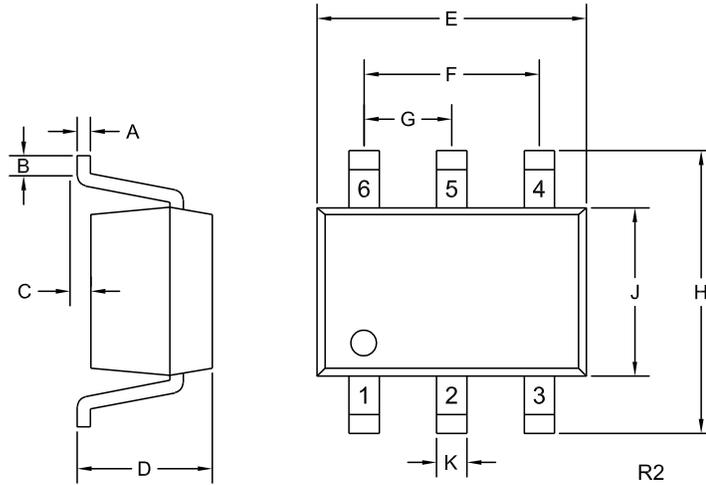
R0 (19-September 2011)

CMKD3003DO

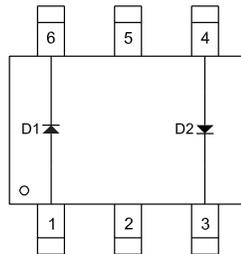
SURFACE MOUNT
DUAL, ISOLATED, OPPOSING
LOW LEAKAGE SILICON
SWITCHING DIODES



SOT-363 CASE - MECHANICAL OUTLINE



PIN CONFIGURATION



LEAD CODE:

- 1) Anode D1
- 2) NC
- 3) Cathode D2
- 4) Anode D2
- 5) NC
- 6) Cathode D1

MARKING CODE: C303

| SYMBOL | INCHES | | MILLIMETERS | |
|--------|--------|-------|-------------|------|
| | MIN | MAX | MIN | MAX |
| A | 0.004 | 0.010 | 0.10 | 0.25 |
| B | 0.005 | - | 0.12 | - |
| C | 0.000 | 0.004 | 0.00 | 0.10 |
| D | 0.031 | 0.043 | 0.80 | 1.10 |
| E | 0.071 | 0.087 | 1.80 | 2.20 |
| F | 0.051 | | 1.30 | |
| G | 0.026 | | 0.65 | |
| H | 0.075 | 0.091 | 1.90 | 2.30 |
| J | 0.043 | 0.055 | 1.10 | 1.40 |
| K | 0.006 | 0.012 | 0.15 | 0.30 |

SOT-363 (REV: R2)

R0 (19-September 2011)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9